

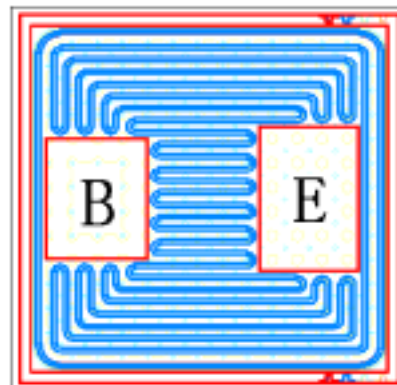


772 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：A105BJ-00
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：1050×1050μm²
 焊位尺寸：B 极 280×345μm²；E 极 275×415μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：2SB772，HS772，H772

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (TO-126、TO-126ML)

T_{stg}——贮存温度.....-55~150
 T_j——结温..... 150
 P_C——集电极功率耗散 (T_c=25) 10W
 P_C——集电极功率耗散 (T_A=25)1W
 V_{CB0}——集电极—基极电压.....-40V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....-30V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....-5V
 I_C——集电极电流.....-3A
 I_B——基极电流.....-0.6A

电参数 (T_a=25) (TO-126、TO-126ML)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			-1	μA	V _{CB} =-30V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			-1	μA	V _{EB} =-5V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	60		400		V _{CE} =-2V, I _C =-1A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和压降		-0.3	-0.5	V	I _C =-2A, I _B =-0.2A
V _{BE(sat)}	基极—发射极饱和压降		-1.0	-2.0	V	I _C =-2A, I _B =-0.2A
C _{ob}	共基极输出电容		55		pF	V _{CB} =-10V, I _E =0, f=1MHz
f _T	特征频率		80		MHz	V _{CE} =-5V, I _E =-0.1A